

2SB502A/503A シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ

通信工業用

単位：mm

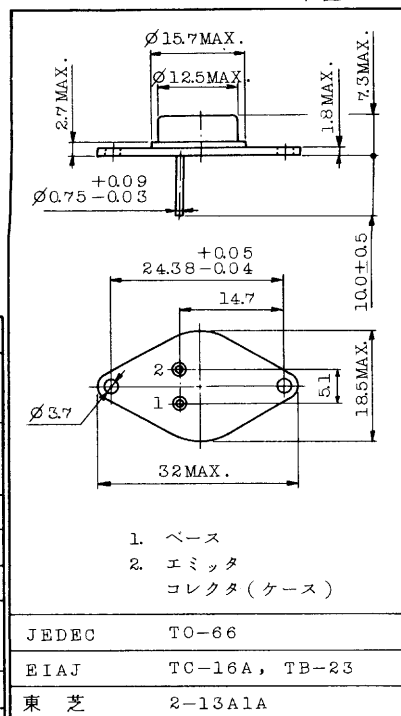
- 低周波電力増幅用
- 定電圧電源用

特長

- ・ コレクタ損失が25W得られます。： $P_C = 25W$ ($T_c = 25^\circ C$)
- ・ 飽和電圧が低い。： $V_{CE(sat)} = -1.5V$ (最大) ($I_C = -3A$)
- ・ エミッタ耐圧が高い。： $V_{EBO} = -10V$
- ・ 2SD877 とコンプリメンタリになります。

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項	目	記号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	2SB502A	V_{CBO}	-110	V
	2SB503A		-80	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SB502A	V_{CEO}	-80	V
	2SB503A		-50	
エミッタ・ベース間電圧		V_{EBO}	-10	V
コレクタ電流		I_C	-3	A
ベース電流		I_B	-1	A
コレクタ損失	$T_a = 25^\circ C$	P_C	1.5	W
	$T_c = 25^\circ C$		25	
接 合 温 度		T_j	150	$^\circ C$
保 存 温 度		T_{stg}	-65~150	$^\circ C$



アクセサリはAC74を適用

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項	目	記号	測 定 条 件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	2SB502A	I_{CBO}	$V_{CB} = -110V, I_E = 0$	—	—	-100	μA
	2SB503A		$V_{CB} = -80V, I_E = 0$	—	—	-100	
エミッタシャ断電流		I_{EBO}	$V_{EB} = -10V, I_C = 0$	—	—	-100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SB502A	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -100mA, I_B = 0$	-80	—	—	V
	2SB503A			-50	—	—	
直 流 電 流 増 幅 率		$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	30	80	280	
		$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -5V, I_C = -2.5A$	15	25	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C = -3A, I_B = -0.3A$	—	—	-1.5	V
ベース・エミッタ間飽和電圧		$V_{BE(sat)}$	$I_C = -3A, I_B = -0.3A$	—	—	-1.8	V
トランジション周波数		f_T	$V_{CB} = -10V, I_C = -0.5A$	—	5	—	MHz
コレクタ出力容量		C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	200	—	pF
スイッチング時間	ターンオン時間	t_{on}		—	1.0	—	μs
	蓄積時間	t_{stg}		—	3.0	—	
	下降時間	t_f		—	1.0	—	

注： $h_{FE(1)}$ 分類 R：30~70, O：50~140, Y：100~280